

а 2007 0192

Изобретение относится к способам термической обработки полупроводниковых материалов и может быть использовано в микроэлектронике.

Сущность изобретения состоит в модификации приповерхностных слоев монокристалла селенида цинка, которая включает термообработку монокристаллов в расплаве висмута с добавкой 0,02...1,10 ат. % хрома при температуре 1000...1200оС в течение 60...150 часов.

Результат состоит в расширении функциональных возможностей устройств, полученных на основе монокристаллов селенида цинка, легированных хромом из расплава висмута, а также в улучшении стехиометрии в процессе легирования.

П. формулы: 1

Фиг.: 2